[18014]

極微小デバイスへの放射線照射損傷機構の解明

Elucidation of radiation degradation mechanism to ultra-small semiconductor devices

学術論文 (査読あり)

- [1] Authors, "Title," Journal **Volume**, pp (Year).
- [2] 著者名, 「論文題名」, 論文誌 号数, ページ (発刊年) .
- [3]

学術論文 (査読なし)

- [1]
- [2]
- [3]

博士論文

- [1]
- [2]

修士論文

- [1]
- [2]

卒業論文

- [1]松木賢斗, “ダイヤモンド SPND の耐環境性能評価,” 熊本高等専門学校専攻科特別研究論文, (2019).
- [2]

国際会議

- [1]H. Kanakogi, T. Nishijima, K. Takakura and I. Tsunoda, “Electron irradiation effect on Sn induced lateral crystallization for amorphous Ge on insulating substrate,” 37th Electron Materials Symposium, Fr1-7 (2018)
- [2]T. Hamasaki, T. Sakai, K. Takakura and I. Tsunoda, “Evaluation of Au concentration for Au induced lateral crystallized Ge on insulating substrate,” 37th Electron Materials Symposium, Fr1-5 (2018).
- [3]N. Shimizu, T. Mori, K. Takakura and I. Tsunoda, “Low temperature formation of Ge (111)/Au/SiO₂ by two step annealing,” 37th Electron Materials Symposium, Fr1-6 (2018).
- [4]K. Matsuki, A. Toda, T. Matsumoto, N. Tokuda and K. Takakura, “Performance evaluation of diamond Schottky PN diode at cryogenic temperature,” 37th Electron Materials Symposium, Fr1-26 (2018).
- [5]N. Aida, K. Ibino, K. Maki and K. Takakura, “Evaluation of Electrical characteristics of Si-doped Ga₂O₃ thin film Si addition effect by multilayer film formation,” 37th Electron Materials Symposium, Th2-7 (2018).
- [6]Kento Matsuki, Kento Iseri, Kenichiro Takakura, Masashi Yoneoka, Isao Tsunoda, Anabela Veloso, Eddy Simoen and Cor Claeyss, “Radiation influence on transconductance of n-channel Silicon-on-Insulator Gate-All-Around FETs by 2 MeV electron irradiation,” The 8th Forum on the Science and Technology of Silicon Materials, (2018).
- [7]Naoya Aida, Hiroki Ishimoto, Isao Tsunoda and Kenichiro Takakura, “Crystallinity Evaluation of Si-doped Ga₂O₃ thin film growth on Al₂O₃ (0001) substrate by RF Magnetron Sputtering,” The 8th Forum on the Science and Technology of Silicon Materials, (2018).

国内会議

- [1]清水 昇, 森 貴礼, 岡本 健人, 坂井 拓也, 高倉 健一郎, 角田 功, “ダイヤモンドショットキーPN ダイオードの低温動作,” 第 65 回応用物理学会春季学術講演会講演予稿集 p.18-206 (2018). [2]田原博隆, 池上伊吹, 下田優希, 高倉健一郎, “廃炉創造ロボコンにおける熊本高専の取り組み,” 次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス (NDEC3) 53 (2018).
- [3]下田優希, 松木賢斗, 米岡将士, 角田功, 高倉健一郎, “3 次元構造により微細化した FET の放射線耐性に関する研究,” I R I D シンポジウム, (2018).
- [4]濱崎 健, 坂井 拓也, 角 和章, 高倉 健一郎, 角田 功, “Au 誘起横方向成長した結晶 Ge 内の Au 濃度評価,” 第 7 9 回応用物理学会秋季学術講演会, (2018).
- [5]鹿子木 嘉城, 佐藤 亮起, 西嶋 泰樹, 小川 大輔, 高倉 健一郎, 角田 功, “非晶質 Ge/SiO₂ の Sn 誘起横方向低温(<=200℃) 固相成長,” 第 7 9 回応用物理学会秋季学術講演会, (2018).

[18014]

[6]鹿子木 嘉城, 佐藤 亮起, 西嶋 泰樹, 小川 大輔, 高倉 健一郎, 角田 功, “電子線照射 a-Ge/SiO₂ の Sn 誘起横方向成長,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, O-12 (2018).

[7]合田 直弥, 井樋野 晃生, 牧 謙汰, 角田 功, 高倉健一郎, “Ga₂O₃ 薄膜導電率向上のための多層膜による Si 添加方法の検討,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-17 (2018).

[8]清水 昇, 森 貴礼, 高倉 健一郎, 角田 功, “Au 拡散抑制した Au 誘起成長法による結晶 Ge の高品質形成,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-18 (2018).

[9]西嶋 泰樹, 草野欽太, 高倉 健一郎, 角田 功, “Au 誘起横方向成長により低温形成した結晶 Ge 薄膜中の Au 濃度評価,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-19 (2018).

[10]濱崎 健, 坂井 拓也, 角 和章, 高倉 健一郎, 角田 功, “Au 触媒量を変調した GILC 法により形成した結晶 Ge の結晶性評価,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-20 (2018).

[11]村田 拳将, 高倉 健一郎, 角田 功, “その場観察法を用いた非晶質 Ge 薄膜の金属誘起横方向成長の評価,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-21 (2018).

[12]下田 優希, 松木 賢斗, 米岡 将士, 角田 功, “電子線照射 SOI GAAFET の伝達コンダクタンスによる損傷度比較,” 第 10 回半導体材料・デバイスフォーラム, P-22 (2018).

招待講演等

[1]

[2]

解説・記事等

[1]

[2]

新聞発表等

[1]

[2]

特許等

[1]

[2]